

# Silicon-Diode

## **1S438**

800V / 3A

# DATASHEET

OEM – Texas Instruments

Source: Texas Instruments Databook 1968/69

**Diffundierter Silizium-Gleichrichter**

**1S430, 1S431, 1S432, 1S434, 1S436, 1S438,  
1S430R, 1S431R, 1S432R, 1S434R, 1S436R,  
1S438R**

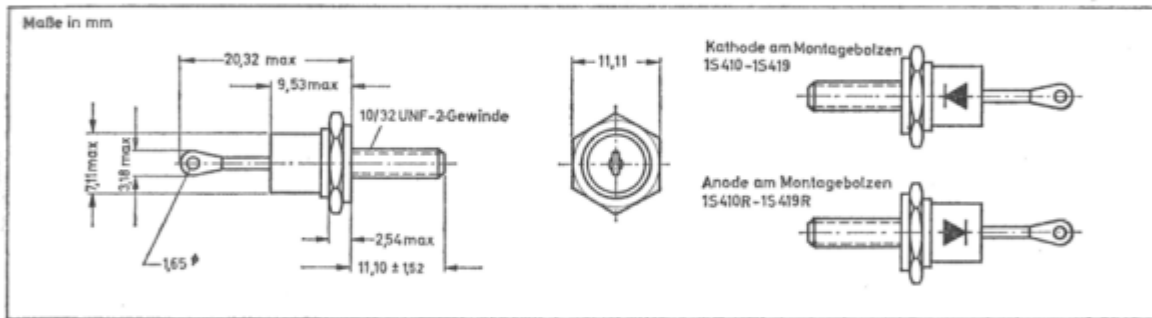
**Mittlerer Gleichstrom 3 A**  
**50—800 Volt Sperrspannung**  
**100—1600 Volt Spitzensperrspannung**  
**Kleiner Längswiderstand**  
**Für industrielle Anwendung bestens geeignet**  
**In beiden Polungsarten erhältlich**

**Mechanische Daten**

Hermetisch verschweißtes Glas-Metall-Gehäuse.

Gewicht: ca. 4,36 g.

Die Gehäuseabmessungen entsprechen VASCA SO-10.



**Absolute Grenzwerte**

	1S430	1S431	1S432	1S434	1S436	1S438	Einh.
	1S430R	1S431R	1S432R	1S436R	1S436R	1S438R	
Sperrspannung	50	100	200	400	600	800	V
Spitzensperrspannung (Bem. 1)	100	200	400	800	1200	1600	V
Richtstrom bei +125 °C	3	3	3	3	3	3	A
Richtstrom bei +145 °C	1	1	1	1	1	1	A
Periodischer Spitzenstrom bei +125 °C	15	15	15	15	15	15	A
Lagerungstemperaturbereich	← -40 °C bis +150 °C →						

**Bemerkung:**

1. Die Spitzensperrspannung darf maximal 10 ms anliegen.

---

**Elektrische Kennwerte** (bei angegebener Gehäusetemperatur)

		1S430	1S431	1S432	1S434	1S436	1S438	Einh.
		1S430R	1S431R	1S432R	1S434R	1S436R	1S438R	
$I_R$	Max. Reststrom bei der Sperrspannung und bei +25°C	5	5	5	5	5	5	µA
$I_R$	Max. Reststrom bei der Sperrspannung und bei +150 °C	300	300	300	300	300	300	µA
$U_F$	Max. Durchlaßspannungsabfall bei $I_F = 10$ A und +25 °C	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	V

---